1P009

質量分析測定に基づく反応性プラズマ中での 分子成長過程に関する考察

(九州大院総理工¹,九州大基幹²,九州大院理³)<u>古屋謙治^{1,2}</u>,川原嗣史¹,坂井麻希子¹, 津奈木省吾¹,鶴川翔太¹,玉井裕二¹,白山靖之³,井手章博¹, 奥村洋史¹,雪田忍¹,原田明¹

Growth Mechanisms of Molecules in Reactive Plasmas by Mass Spectrometric Investigation

(Kyushu Univ.) <u>Kenji Furuya</u>, Hideshi Kawahara, Makiko Sakai, Shogo Tsunagi, Shota Tsurukawa, Yuji Tamai, Yasuyuki Shiroyama, Akihiro Ide, Hiroshi Okumura, Shinobu Yukita, Akira Harata

【序論】CH₄プラズマや C₂H₂プラズマは炭素材料開発やダスト発生の観点から注目を集めており、様々な研究が報告されている。ダストの成長に関しては、ダスト自身がプラズマ中で負に帯電していること、SiH₄プラズマでは珪素数が 40 を超える巨大な負イオンが観測されていることから、負イオンを核とする気相中でのダストの成長機構が提唱されている[1]。しかしながら、CH₄プラズマや C₂H₂プラズマ中で観測されている負イオンは炭素数 10 前後までである[2]。したがって、ダストの発生、特に、その初期過程の研究においては、更に実験事実を積み重ねるとともに詳細な検討が必要である。我々のこれまでの研究により、SiH₄プラズマ中での成長機構が炭化水素プラズマやパーフルオロカーボン(PFC)プラズマ中では必ずしも当てはまらないことが解ってきた。本発表では、様々なパーフルオロカーボンや、CHF₃、CH₄、C₂H₂プラズマで得た実験結果をもとに、プラズマガスの違いによる分子成長機構の違いを総括的に報告する。

【実験】詳細については文献[3]に記載している。いずれの測定においても、導入ガスの全圧1 Pa、RF 電力150 W で誘導結合プラズマを発生させ、その下流域において Li⁺を中性化学種に低速で衝突させて生成した Li⁺ 付着物を質量分析計に導き、質量スペクトルを測定(Li⁺-IAMS 測定)した。また、堆積膜のない状態からプラ ズマを発生させ、いくつかの化学種の強度の時間変化を測定した。

【CH₄プラズマ】純 CH₄プラズマの Li⁺-IAMS 測定では炭素数 27 に至る様々な炭化水素が観測されたが、 いずれも水素数は偶数個であり、¹³C の同位体存在比を明らかに超えるような、水素数が奇数個のラジ カルに帰属できるピークを確認することはできなかった。この傾向は、CH₄分圧を 0.2 Pa まで下げて も変化しなかった。一方、正イオンの質量分析では、高々炭素数 14 程度までしか観測されず、また、 水素数の偶奇性に由来する強度交替も観測されなかった。

次に、純 CH₄プラズマで 30 分間アモルファス炭化水素(a-C:H) 膜を堆積させた後、Ar プラズマ中 で Li⁺-IAMS 測定を行った。この条件でも炭素数の大きな様々な化学種が観測された。Ar プラズマに H₂ を添加することにより質量スペクトルのピーク強度は増大した。この傾向は中性分子の方が顕著で

あった。また、純 CH_4 プラズマ下流域で観測された中性分子の質量スペクトルでは C_3H_{10} が最も強く観測されたのに対し、a-C:H 膜堆積後の Ar プラズマや Ar/H_2 プラズマの場合では質量スペクトルの強度分布が高質量数側へシフトし、 C_8H_{16} が最も強かった。

さらに、a-C:H 膜が堆積していない状態から CH₄分圧 0.03 Pa以下の条件でプラズマを発生さ せ、いくつかのマスピーク強度の時間依存性を 測定した。その結果を図 1 に示す。プラズマ発 生と同時に C₃H₆ と C₄H₈の強度は急峻に立ち上 がり、時間とともに減少していく。一方、他の ピークは時間とともに緩やかに立ち上がってい る。C₇H₁₄のピークの立ち上がりは、CH₄分圧を 下げるにつれてさらに緩やかとなった。時刻 0 付近を 5s の分解能で測定したところ、C₃H₆強度



が最大となるまでには 120 s を要していた。本装置におけるガスの滞在時間は 60 ms であるため、もっ とも急峻な強度の立ち上がりを示した C₃H₆ですら、気相反応によって生成したとは考えられない。

本実験装置では、チェンバー内壁全域に渡って均一に膜が堆積するのではなく、プラズマ発生時間 の増加に伴って、膜の面積が増加していく。この事実を考慮し、得られた実験結果から次のような反 応機構を考えている。すなわち、

・プラズマ中で CH₄の分解により生成した CH_x(x=1-3) ラジカルはプラズマ発生部に使用されてい る石英管表面に吸着し、表面反応により成長して炭素数を増す。

・石英管表面からは、C₃H₆やC₄H₈のような比較的小さな分子が放出される。よって、膜面積の増加と ともにそれらの放出は抑制される。

・厚い a-C:H 膜表面からは、C7H14のような、より炭素数の多い分子が放出される。

・中間的な大きさの分子は、ごく薄い堆積膜表面から生成している。

・CH4の分圧が大きくなるにつれて気相中に存在する大きな分子の濃度は高くなる。それらの一部は プラズマ中で再び分解され、小さな分子を生成する。

本研究結果は、反応性プラズマ中だから気相中で観測された質量数の大きな分子は気相で成長して いる、という短絡的な考えは当てはまらないことを示している。

【C2H2プラズマ】C2H2プラズマでもチェンバー内壁に膜が堆積するが、その堆積速度はCH4プラズマよりC2H2 プラズマの方が著しく速い。Li⁺-IAMS観測結果は、Ar/C₂H₂ = 1.0/0.03 Paプラズマでは炭素数4までの炭化水 素分子が観測されたに過ぎない。プラズマ中における微粒子生成の研究報告数は C₂H, プラズマの方がはる かに多く、分子レベルから微粒子成長へ至る反応が気相中で進行していれば、様々な分子サイズの化学種が C2H2プラズマ中で観測されるはずである。従って我々は、C2H2プラズマ中で生成する微粒子は堆積膜の部分 的な崩壊と帯電を通して直接気相中へ放出される、という生成機構を提案する。

【CF₄プラズマ】CH₄プラズマとは異なり、CF₄プラズマでは Ar を混合しなくても膜は全く堆積しない。 CとFのみから構成される化合物としては C_nF_{2n+2} と C_nF_{2n} 系列、および C_8F_{14} が Li⁺-IAMS で観測され た。また、これらの強度は Ar/CF₄混合ガスにおける CF₄の分圧上昇に伴って増大していくのに対し、 正イオンの質量分析で観測された C_nF_{2n+1}⁺や C_nF_{2n-1}⁺の強度は CF₄分圧 30%で最も大きく、それ以上に CF4分圧を上昇させると、正イオンの強度はいずれも低下した。このことは、中性種の成長反応と正イ オンの成長反応が独立であることを示している[4]。いくつかのピークについて、図1と同様に強度の 時間変化を測定したところ、図2の結果を得た。Ar/CH4プラズマの場合とは異なり、いずれのピーク

も炭素数に関わらずプラズマ発生と同時に急峻 に強度が増大した後、ほぼ一定の強度を保って いる。強度の立ち上がりに要した時間は本装置 で測定可能な時間分解能(5 s)以下であった。 この実験結果は、Ar/CF4プラズマ中で観測され た質量数の大きな分子が気相反応によって成長 していることを示唆している。しかしながら、 その成長機構を説明するには高濃度のCF₃CFの 存在を仮定しなければならず[5]、未だ確証は得 られていない。

【C₂F₄, C₃F₈, C₄F₆, c-C₄F₈, CHF₃プラズマ】PFC プラズマではいずれも、PFC の分圧がある値以上 で膜が堆積した。CF4プラズマ中で観測された様々 な $C_n F_{2n+2}$ や $C_n F_{2n}$ の強度は、プラズマ発生と同時 に立ち上がり、その後一定の強度を示した。一方、 Ar/C₃F₈ プラズマにおいては、プラズマ発生後に数 100 秒かかって一定強度に達する化学種がいくつ



Li⁺付着物強度の時間依存性

か確認された。Ar/CHF3プラズマでも、プラズマ発生と同時に強度が一定値に達する化学種やプラズマ発生後 に数 100 秒かかって一定強度に達する化学種だけでなく、プラズマ発生直後に出現し、その後徐々に強度が 減少していく化学種も観測された。従って、CF4を除く Ar/PFC プラズマや Ar/CHF3プラズマでは、気相中で成 長する化学種と堆積膜のスパッタリングで気相中に放出される化学種の両方の寄与があると考えられる。

【参考文献】

- 1. Ch. Hollenstein, Plasma Phys. Control. Fusion 42 (2000) R93.
- 2. Ch. Deschenaux, A. Affolter, D. Magni, Ch. Hollenstein and P. Fayet, J. Phys. D 32 (1999) 1876.
- 3. K. Furuya, A. Ide and A. Harata, J. Appl. Phys. 110 (2011) 013304.
- 4. K. Furuya, S. Yukita, H. Okumura and A. Harata, Chem. Lett. 34 (2005) 224.
- 5. K. Furuya, A. Ide, H. Okumura and A. Harata, Phys. Chem. Chem. Phys. 11 (2009) 934.